

## 第2章 特許

### 1. 特許登録状況

#### 加工プロセス工学研究部門

2004	9	7	Ternary alloy and apparatus thereof	US 6,786,984 B1 アメリカ合衆国
------	---	---	-------------------------------------	----------------------------

#### 複合機能材料学研究部門

2004	12	3	粒子分散複合物及びそれを用いた固体電解質型センサー	特許第3624196号 日本国
------	----	---	---------------------------	--------------------

#### 結晶材料化学研究部門

2004	10	22	圧電基板の材料定数測定方法および装置	特許第3608498号 日本国
------	----	----	--------------------	--------------------

2004	10	22	圧電基板の材料定数測定装置	特許第3608499号 日本国
------	----	----	---------------	--------------------

#### 磁性材料学研究部門

2004	6	18	磁性多層膜およびその製造方法ならびに光磁気記録媒体	特許第3559332号 日本国
------	---	----	---------------------------	--------------------

2004	6	18	磁性多層膜およびその製造方法ならびに光磁気記録媒体	特許第3559333号 日本国
------	---	----	---------------------------	--------------------

2004	11	30	Method of Making Magnetic Multilayer Film, Method of Making Magnetic Recording Medium, Magnetic Multilayer Film, and Magnetic Recording Medium	US6824817B2 アメリカ合衆国
------	----	----	--	------------------------

#### 非平衡物質工学研究部門

2004	6	4	軟磁性Co基金属ガラス合金	特許第3560591号 日本国
------	---	---	---------------	--------------------

2004	6	4	高比表面積複合酸化物の製造方法	特許第3561008号 日本国
------	---	---	-----------------	--------------------

#### 超構造薄膜化学研究部門

2004	4	27	Transistor and Semiconductor Device	6727522 アメリカ合衆国
------	---	----	-------------------------------------	--------------------

2004	6	9	Semiconductor Device	0436651 大韓民国
------	---	---	----------------------	-----------------

2004	6	9	Transistor and Semiconductor Device	0436654 大韓民国
------	---	---	-------------------------------------	-----------------

2004	11	2	Optical semiconductor element utilizing optical transition between ZnO heterostructure sub-bands	6812483 アメリカ合衆国
------	----	---	--	--------------------

2005	2	15	Composite Integrated Circuit and its Fabrication Method	6855972 アメリカ合衆国
------	---	----	---	--------------------

2005	3	11	Method for preparing single crystal oxide thin film	0478123 大韓民国
------	---	----	---	-----------------

## 2. 特許出願状況

### 金属物性論研究部門

2004 7 27	特願2004-219284	日本国
2004 12 24	特願2004-375008	日本国

### 結晶物理学研究部門

2004 6 4	10/860060号	アメリカ合衆国
2004 6 9	04013647.5 (EP)	ドイツ連邦共和国
2004 7 16	PCT/JP2004/10213	アメリカ合衆国
2004 8 27	特願2004-248341	日本国
2004 8 27	JSP海外出願番号:2004-248341	アメリカ合衆国、ドイツ
2004 9 14	特願2004-266982	日本国
2005 2 21	特願2005-043360	日本国
2005 2 21	特願2005-44025	日本国

### 高純度金属材料学研究部門

2004 9 27	特願2004-280144号	日本国
2004 10 20	特願2004-305646号	日本国

### 原子力材料物性学研究部門

2004 8 2	特願2004-225430	日本国
2004 9 17	特願2004-271199	日本国
2004 10 27	特願2004-297770	日本国
2005 1 25	特願2005-16248	日本国
2005 2 1	特願2005-25069	日本国

### 超構造薄膜化学研究部門

2004 4 28	特願2004-134342	日本国
2004 5 12	10/451,378	アメリカ合衆国
2004 8 6	特願2004-231061	日本国
2004 9 14	特願2004-267239	日本国
2005 1 29	10/765,901	アメリカ合衆国

### 非平衡物質工学研究部門

2004 4 1	特願2004-108941	日本国
----------	---------------	-----

2004 4 7	特願2004-113626	日本国
2004 4 7	特願2004-113630	日本国
2004 4 7	特願2004-113630	日本国
2004 5 17	特願2004-146910	日本国
2004 5 17	特願2004-136450	日本国
2004 5 26	特願2004-156467	日本国
2004 5 28	特願2004-160231	日本国
2004 5 28	特願2004-160232	日本国
2004 6 11	特願2004-174409	日本国
2004 6 16	特願2004-178027	日本国
2004 9 2	特願2004-255456	日本国
2004 10 6	特願2004-294031	日本国
2004 10 26	特願2004-310862	日本国
2004 11 11	特願2004-327675	日本国
2004 11 15	特願2004-160234	日本国
2004 11 15	特願2004-330308	日本国
2004 11 15	特願2004-330411	日本国
2004 12 8	特願2004-355520	日本国
2004 12 24	特願2005-024843	日本国
2004 12 24	特願2004-373662	日本国
2004 12 31	特願2002-199130	日本国
2005 3 1	特願2005-056498	日本国
2005 3 9	特願2005-065297	日本国
2005 3 14	特願2005-071642	日本国
2005 3 28	特願2005-92072	日本国

#### 磁性材料学研究部門

2004 3 25	PCT/JP2004/004152	PCT加盟国
2004 3 29	特願2004-096591	日本国

#### 結晶材料化学研究部門

2004 8 6	特願2004-228158	日本国
2004 8 24	特願2004-24479	日本国
2005 2 1	特願2005-24935	日本国

#### 特殊耐熱材料学研究部門

2004 6 25	特願2004-187342	日本国
2004 10 8	PCT/JP2004/014966	

#### 複合機能材料学研究部門

2004 9 16	特願2004-045325	日本国
2004 9 16	PCT/JP2004/13561	

#### 加工プロセス工学研究部門

2004 5 28	特願2004-158825	日本国
-----------	---------------	-----